









	<h2 style="color: red;">IPT60R125G7XTMA1</h2>
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	<p>Hersteller-Teilenummer: IPT60R125G7XTMA1</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 650V 20A HSOF-8</p> <hr/> <p>Datenblätter:  IPT60R125G7XTMA1.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPT60R125G7XTMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 20A HSOF-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 320µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-HSOF-8
Serie	CoolMOS™ G7
Rds On (Max) @ Id, Vgs	125 mOhm @ 6.4A, 10V
Verlustleistung (max)	120W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	8-PowerSFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1080pF @ 400V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	27nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20A (Tc)

IPT60R125G7XTMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPT60R125G7XTMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPT60R125G7XTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPT60R125G7XTMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPT60R080G7XTMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 29A HSOF-8</p>	 <p>IPT60R102G7XTMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 23A HSOF-8</p>	 <p>IPT60R028G7XTMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 75A HSOF-8</p>	 <p>IPT65R195G7XTMA1 Infineon Technologies HIGH POWER_NEW</p>
 <p>IPT60R150G7XTMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 17A HSOF-8</p>	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	 <p>IPT65R033G7XTMA1 Infineon Technologies HIGH POWER_NEW</p>	 <p>IPT210N25NFDATMA1 Infineon Technologies MV POWER MOS</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPT60R125G7XTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPT60R125G7XTMA1 Datenblatt	IPT60R125G7XTMA1-Datenblätter	IPT60R125G7XTMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPT60R125G7XTMA1
IPT60R125G7XTMA1 Electronic	IPT60R125G7XTMA1-Komponenten	IPT60R125G7XTMA1-Verteiler	IPT60R125G7XTMA1-Bild	IPT60R125G7XTMA1-Teil
IPT60R125G7XTMA1 Preis	IPT60R125G7XTMA1 Hersteller	IPT60R125G7XTMA1 Bild	IPT60R125G7XTMA1 Aktie	IPT60R125G7XTMA1 Inventar
IPT60R125G7XTMA1 Neu	IPT60R125G7XTMA1 Original	IPT60R125G7XTMA1 garantiert	IPT60R125G7XTMA1 RFQ	IPT60R125G7XTMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited